



	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI6463BDQ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI6463BDQ-T1-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1495 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI6463BDQ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1495 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	SI6463BDQ-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.2A (Ta) 1.05W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

SI6463BDQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6463BDQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6463BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI6463BDQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6463DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6463DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI6463BDQ.</b> VIS SI6463BDQ. VIS</p>	 <p><b>SI6463BDQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6463BDQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>
 <p><b>SI6463DQ</b> SI SI6463DQ SI</p>	 <p><b>SI6463ADQ-T1</b> SIL SI6463ADQ-T1 SIL</p>	 <p><b>SI6463DQ-T1</b> SIL SI6463DQ-T1 SIL</p>	 <p><b>SI6463BDQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>

SI6463BDQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6463BDQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6463BDQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6463BDQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI6463BDQ-T1-GE3 Electronic	SI6463BDQ-T1-GE3-Komponenten	SI6463BDQ-T1-GE3-Verteiler	SI6463BDQ-T1-GE3-Bild	SI6463BDQ-T1-GE3-Teil	SI6463BDQ-T1-GE3-Teil
SI6463BDQ-T1-GE3 Preis	SI6463BDQ-T1-GE3 Hersteller	SI6463BDQ-T1-GE3 Bild	SI6463BDQ-T1-GE3 Aktie	SI6463BDQ-T1-GE3 Inventar	SI6463BDQ-T1-GE3 Inventar
SI6463BDQ-T1-GE3 Neu	SI6463BDQ-T1-GE3 Original	SI6463BDQ-T1-GE3 garantiert	SI6463BDQ-T1-GE3 RFQ	SI6463BDQ-T1-GE3 Online bestellen	SI6463BDQ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited